

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 4 月 17 日(17.04.2014)



(10) 国際公開番号

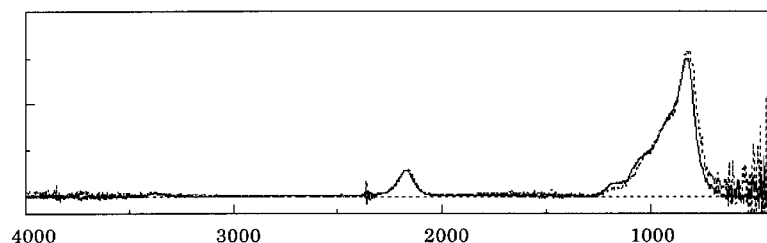
WO 2014/057980 A1

- (51) 国際特許分類:
B05D 7/24 (2006.01) C01B 21/068 (2006.01)
B05D 3/06 (2006.01) C08J 7/00 (2006.01)
B32B 9/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/077487
- (22) 国際出願日: 2013 年 10 月 9 日(09.10.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-226078 2012 年 10 月 11 日(11.10.2012) JP
- (71) 出願人: A Z エレクトロニックマテリアルズマ
ニュファクチャリング株式会社(AZ ELECTRON-
IC MATERIALS MANUFACTURING (JAPAN) KK)
[JP/JP]; 〒1130021 東京都文京区本駒込 2 丁目 2
8 番 8 号 文京グリーンコート Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 尾崎 祐樹(OZAKI Yuki); 〒4371412 静岡
県掛川市千浜 3 3 3 0 A Z エレクトロニック
マテリアルズマニュファクチャリング株式会
社内 Shizuoka (JP). 櫻井 貴昭(SAKURAI Takaaki);
〒4371412 静岡県掛川市千浜 3 3 3 0 A Z エ
レクトロニックマテリアルズマニュファクチャ
リング株式会社内 Shizuoka (JP). 小林 政一
(KOBAYASHI Masakazu); 〒4371412 静岡県掛川市
千浜 3 3 3 0 A Z エレクトロニックマテリア
ルズマニュファクチャリング株式会社内
Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 勝沼 宏仁, 外(KATSUNUMA Hirohito et
al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内 1 丁目 6 番
6 号 日本生命丸の内ビル 協和特許法律事務
所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: METHOD FOR FORMING DENSE SILICIC FILM

(54) 発明の名称: ケイ素質緻密膜の形成方法

[図1]



(57) Abstract: [Problem] To provide a dense silicic film and a method for forming the film. [Solution] A method for forming a dense silicic film which comprises applying, on a substrate, a composition for coating film formation which contains a polymer having silazane bonds, thereby forming a film, irradiating the film with light having a maximum peak wavelength of 160-179 nm, and successively irradiating the film with light having a maximum wavelength longer by 10-70 nm than the maximum peak wavelength of the light with which the film has been irradiated; and a dense silicic film formed by the method.

(57) 要約: [課題] ケイ素質緻密膜とその形成方法の提供。 [解決手段] シラザン結合を有するポリマーを含んでなる被膜形成用組成物を基板上に塗膜し、最大ピーク波長が160~179 nmである光を照射し、次いで、最大ピーク波長が、その前に照射した光の最大ピーク波長よりも10~70 nm長い光を照射することを含む、ケイ素質緻密膜の形成方法と、それにより形成させたケイ素質緻密膜。



WO 2014/057980 A1